




## МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ M2T2(A,K)-1000

<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <math>V_{DRM} = 400 - 1200 \text{ В}</math></li><li>◆ <math>V_{RRM} = 400 - 1200 \text{ В}</math></li><li>◆ <math>I_{T(AV)} = 1230 \text{ А}</math> (<math>T_C = 70^\circ\text{C}</math>)</li><li>◆ <math>I_{T(AV)} = 1024 \text{ А}</math> (<math>T_C = 85^\circ\text{C}</math>)</li><li>◆ <math>I_{TSM} = 28 \text{ кА}</math> (<math>T_j = 140^\circ\text{C}</math>)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ отвод тепла через алюмонитридную керамику, изолирующую медное основание</li><li>◆ прижимная конструкция</li><li>◆ высокая энерготермоциклостойкость</li><li>◆ ширина корпуса 77 мм</li></ul>	

### МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +140^\circ\text{C}$	$V_{DRM}$	400 - 1200	В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +140^\circ\text{C}$	$V_{RRM}$	400 - 1200	
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +140^\circ\text{C}$	$V_{DSM}$	500 - 1300	
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +140^\circ\text{C}$	$V_{RSM}$	500 - 1300	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_D / V_R = V_{DRM} / V_{RRM}$	$I_{DRM} / I_{RRM}$	100	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, $f = 50 \text{ Гц}$ , $T_C = 85^\circ\text{C}$ $T_C = 70^\circ\text{C}$	$I_{T(AV)}$	1024 1230	А
Действующий ток в открытом состоянии, $T_C = 85^\circ\text{C}$ , $f = 50 \text{ Гц}$	$I_{TRMS}$	1607	
Ударный ток в открытом состоянии, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_R = 0$ , $t_p = 10 \text{ мс}$	$I_{TSM}$	28	кА
Защитный показатель	$I^2t$	$3.9 \times 10^6$	$\text{А}^2\text{с}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$ , $I_T = 2000 \text{ А}$ , $I_{FG} = 1 \text{ А}$ , $t_r = 1 \text{ мкс}$ , $f = 50 \text{ Гц}$	$(di_T/dt)_{crit}$	200	А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$	$(dv_D/dt)_{crit}$	1000	В/мкс
Максимальная мощность управления, постоянный ток	$P_{GM}$	4	Вт
Температура перехода	$T_j$	-60... +140	°C
Температура хранения	$T_{stg}$	-60... +50	

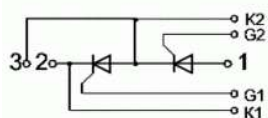
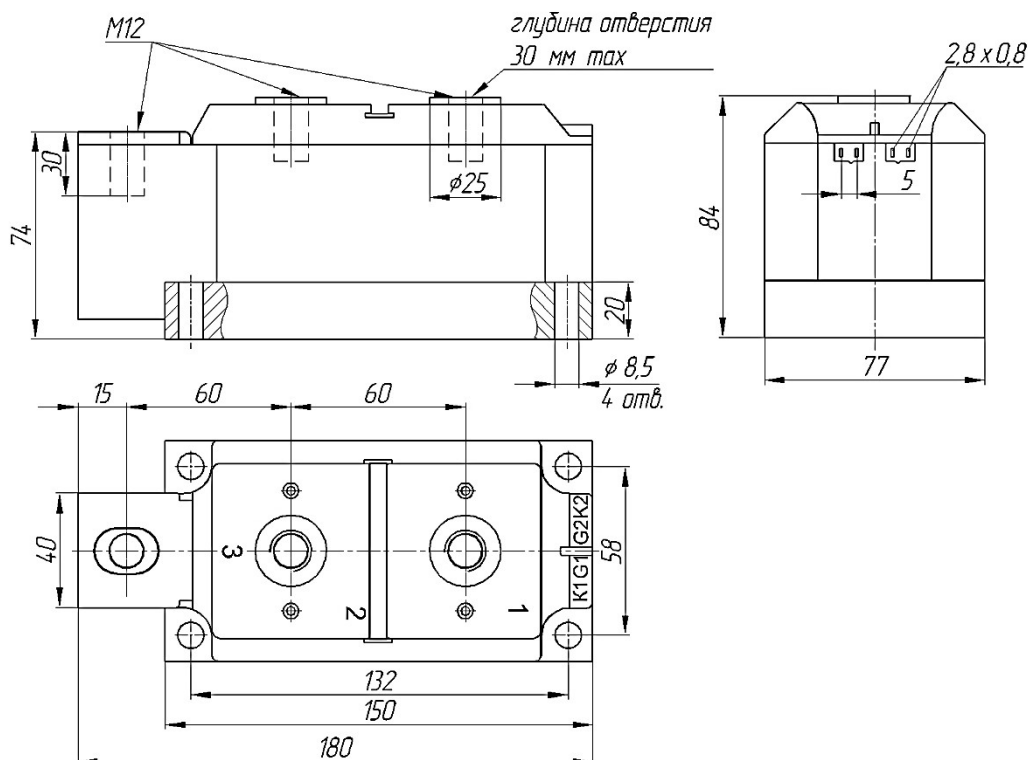


## M2T2(A,K)-1000

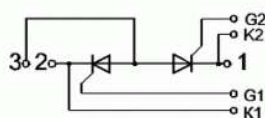
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения	
		мин.	тип.	макс.		
Импульсное напряжение в открытом состоянии, $T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_T = 3140\text{ A}$	$V_{TM}$	-	-	1.35	В	
Пороговое напряжение, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $I_T = 1570 - 4710\text{ A}$	$V_{T(ТО)}$	-	-	0.90		
Динамическое сопротивление, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $I_T = 1570 - 4710\text{ A}$	$r_T$	-	-	0.15	МОм	
Время задержки включения, $T_j = 25^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$ , $I_T = 1000\text{ A}$ , $I_{FG} = 1\text{ A}$ , $t_r = 1\text{ мкс}$	$t_d$	-	-	2.0	мкс	
Время выключения, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $I_T = 1000\text{ A}$ , $di_T/dt = -5\text{ A/мкс}$ , $V_R \geq 100\text{ В}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$ , $dv_D/dt = 50\text{ В/мкс}$	$t_q$	-	250	-		
Заряд обратного восстановления, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $I_T = 1000\text{ A}$ , $di_T/dt = -5\text{ A/мкс}$ , $V_R \geq 100\text{ В}$	$Q_{rr}$	-	-	1500	мкКл	
Ток удержания, $T_j = 25^\circ\text{C}$ , $V_D = 12\text{ В}$	$I_H$	-	-	250	мА	
Отпирающее постоянное напряжение управления, $V_D = 12\text{ В}$ , $T_j = -60^\circ\text{C}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 140^\circ\text{C}$	$V_{GT}$	-	-	3.5 2.5 2.0	В	
Отпирающий постоянный ток управления, $V_D = 12\text{ В}$ , $T_j = -60^\circ\text{C}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 140^\circ\text{C}$	$I_{GT}$	-	-	500 300 250	мА	
Неотпирающее постоянное напряжение управления, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$	$V_{GD}$	0.25	-	-	В	
Неотпирающий постоянный ток управления, $T_j = 140^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$	$I_{GD}$	15	-	-	мА	
Электрическая прочность изоляции (эффективное значение), $f = 50\text{ Гц}$ , $t = 1\text{ сек/1мин}$	$V_{isol}$	-	-	3600/ 3000	В	
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ						
Тепловое сопротивление переход – корпус	на тиристор	$R_{th(j-c)}$	-	-	0.042 0.021	°C/Вт
	на модуль					
Тепловое сопротивление корпус – охладитель	на тиристор	$R_{th(c-h)}$	-	-	0.01 0.02	
	на модуль					
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Масса	w	-	4.0	-	кг	
Крутящий момент на охладителе	$M_s$	8±15%			Нм	
Крутящий момент на токовыводах	$M_t$	18±15%				
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	50	м/с <sup>2</sup>	



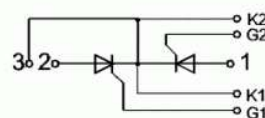
## M2T2(A,K)-1000



M2T2



M2T2A



M2T2K

Габаритные и установочные размеры  
(размеры в мм)



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nic spp@elvpr.ru

Internet: www.elvpr.ru